
	<h2>SI1922EDH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1922EDH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SOT-363</p> <p>Datenblätter:  SI1922EDH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 53671 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1922EDH-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.3A SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	53671 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.25W
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	198 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















SI1922EDH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1922EDH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1922EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1922EDH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1926A Vishay Precision Group SI1926A VISHAY</p>	 <p>SI1917EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 1A SC70-6</p>	 <p>SI19190CTG64 SILICON SILICON QFP64</p>	 <p>SI1917EDH-T1-GE3 VISHAY SI1917EDH-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI1926DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SOT363</p>	 <p>SI19190CT64 SILICON SI19190CT64 SILICON</p>	 <p>SI1926DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SC-70-6</p>	 <p>SI1926DL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 0.37A SOT363</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1905BDH-T1-GE3	 SI1905BDH-TI-E3	 SI1905DL	 SI1905DL-T1	 SI1905DL-T1-E3
 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-GE3	 SI1906DL-T1	 SI1912EDH	 SI1912EDH-T1
 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-GE3	 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-E3
 SI1913DH-T1-GE3	 SI1913EDH-T1	 SI1913EDH-T1-E3	 SI1913EDH-T1-E3	 SI1913EDH-T1-GE3
 SI1917EDH-T1	 SI1917EDH-T1-E3	 SI1917EDH-T1-E3	 SI1917EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3
 SI1926DL-T1-E3	 SI1926DL-T1-E3	 SI1926DL-T1-GE3	 SI1926DL-T1-GE3	 SI1958DH-T1-E3
 SI1958DH-T1-E3	 SI1965DH-E3	 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-GE3
 SI1965DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-E3	 SI1967DH-T1-E3	 SI1967DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-GE3
 SI1969DH-E3	 SI1970DH-T1-GE3	 SI1970DH-T1-GE3	 SI1972DH-T1	 SI1972DH-T1-E3
 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-GE	 SI1972DH-T1-GE3	 SI1972DH-T1-GE3	 SI1973DH-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited